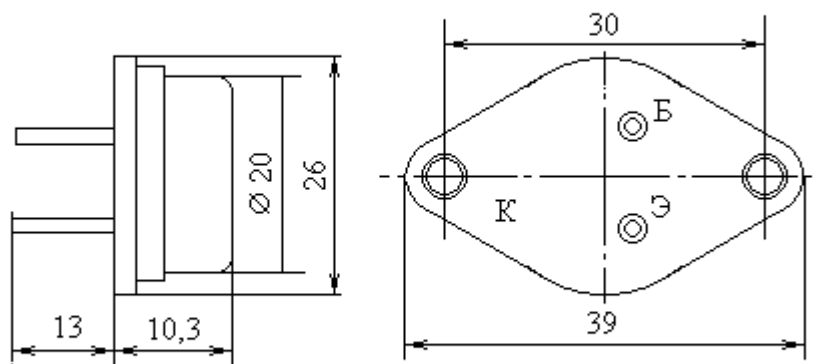


Транзисторы биполярные n-p-n большой мощности низкой и средней частоты



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Название | 2Т819Б |
| Материал | Si |
| $I_k \text{ max}, \text{A}$ | 15 |
| $I_{k \text{ и}}, \text{A}$ | 20 |
| $U_{кэ0 \text{ гр}}(U_{кэ0, \text{ и}} \text{ max})[U_{кэг} \text{ max}], \text{В}$ | 60 |
| $U_{кбо \text{ max}}(U_{кбо, \text{ и}} \text{ max}), \text{В}$ | 80 |
| $U_{эбо \text{ max}}(U_{эбо, \text{ и}} \text{ max}), \text{В}$ | 5 |
| $P_k \text{ max}(P_{k, \text{ ср}} \text{ max})(P_{k, \text{ и}} \text{ max}), \text{Вт}$ | 100 |
| при $T_k(T), \text{C}$ | 25 |
| $T_k \text{ max}(T \text{ max}), \text{C}$ | 125 |
| $h_{21э}(h_{21э})[S_{21} \text{ тип}]$ | 20 |
| при $U_{кэ}(U_{кб}), \text{В}$ | [5] |
| $U_{кэ \text{ нас}}, \text{В}$ | 5 |
| $I_{кб0}(I_{кэг})\{I_{кэ0}\}, \text{mA}$ | 1 |
| $S_k, \text{пф}$ | 3 |
| $S_э, \text{пф}$ | 1000 |
| $t_{выкл}(t_{рас})[t_{сп}], \text{мкс}$ | 2.5 |
| $R_{т \text{ п-к}}(R_{т \text{ п-с}}), \text{C/Вт}$ | 1.25 |